

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-270485

(43)Date of publication of application : 09.10.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/60  
C22C 5/02

(21)Application number : 09-068439

(71)Applicant : TANAKA DENSHI KOGYO KK

(22)Date of filing : 21.03.1997

(72)Inventor : TOKUYAMA TAKESATO  
AKIMOTO HIDEYUKI  
IINO MAMORU  
FUJIMOTO YUSUKE

## (54) GOLD ALLOY WIRE FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT BONDING

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To reduce the height of a loop and obtain an excellent high temperature bonding strength, by using a gold alloy wire composed of at least one kind out of specified amount of palladium(Pd), platinum(Pt) and silver(Ag), a specified amount of bismuth(Bi), gold and inevitable impurities as the residual part.

**SOLUTION:** An alloy wire composed of 0.2-20.0 wt.% of at least one kind out of palladium(Pd), platinum(Pt) and silver (Ag), 0.001-0.01 wt.% of bismuth(Bi), and gold and inevitable impurities as the residual part. An alloy wire wherein at least one kind out of Pd, Pt and Ag is 0.5-5.0 wt.%. An alloy wire wherein at least one kind out of Y, La, Ca and Eu is contained at most 0.1 wt.%. An alloy wire containing beryllium(Be) of at most 0.002 wt.%. By using the above gold alloy wires 3, the height H of a loop can be reduced in response to the demand of the thinning of a semiconductor device, and high temperature bonding strength can be improved.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 26.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3615901

[Date of registration] 12.11.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

特開平10-270485

(43) 公開日 平成10年(1998)10月9日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I		
H01L 21/60	301	H01L 21/60	301	F
C22C 5/02		C22C 5/02		

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平9-68439

(22) 出願日 平成9年(1997)3月21日

(71) 出願人 000217332

田中電子工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

(72) 発明者 徳山 威史

東京都三鷹市下連雀八丁目5番1号 田中

電子工業株式会社三鷹工場内

(72) 発明者 秋元 英行

東京都三鷹市下連雀八丁目5番1号 田中

電子工業株式会社三鷹工場内

(72) 発明者 飯野 守

東京都三鷹市下連雀八丁目5番1号 田中

電子工業株式会社三鷹工場内

(74) 代理人 弁理士 石田 敬 (外3名)

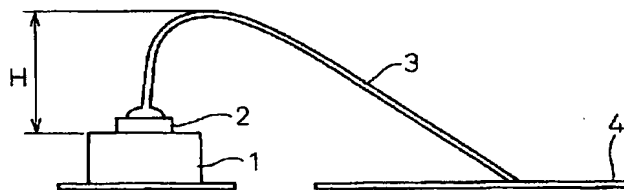
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体素子ボンディング用金合金線

(57) 【要約】

【課題】 ループ高さを低くし、かつ高温接合強度の高い半導体素子ボンディング用金合金線を提供すること。

【解決手段】 Pd, Pt, Agのうち1種以上を0.2~20.0重量%、好ましくは0.5~5.0重量%と、Biを0.0001~0.01重量%含む金合金線。さらには、Y, La, Ca, Euのうち1種以上を0.1重量%以下、さらにはBeを0.002重量%以下添加してもよい。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 パラジウム（Pd）、白金（Pt）、銀（Ag）のうち少なくとも1種を0.2～20.0重量%、ビスマス（Bi）を0.0001～0.01重量%、及び残部が金と不可避不純物からなることを特徴とする半導体素子ボンディング用金合金線。

【請求項2】 パラジウム（Pd）、白金（Pt）、銀（Ag）のうち少なくとも1種が0.5～5.0重量%であることを特徴とする請求項1記載の半導体素子ボンディング用金合金線。

【請求項3】 更にY、La、Ca、Euのうち少なくとも1種を0.1重量%以下含有することを特徴とする請求項1又は2記載の半導体素子ボンディング用金合金線。

【請求項4】 更にベリリウム（Be）を0.002重量%以下含有することを特徴とする請求項3記載の半導体素子ボンディング用金合金線。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体素子の電極と外部リード部を接続するために使用するボンディング用金合金線に関し、さらに詳しくは半導体装置を薄肉化

## 【0002】

【従来の技術】従来からトランジスタ、IC、LSI等の半導体素子の電極と外部リードを接続する技術としては、純度99.99重量%以上の高純度金に他の金属元素を微量含有させた金合金線を用いた超音波併用熱圧着ボンディング法が主として用いられている。

【0003】このようにして接続された状況を図1に示す。図1において1は半導体素子、2は電極、3は金合金線、4はリードフレーム、Hは半導体素子上面を基準としたループ高さ（以下ループ高さという）である。半導体素子1の電極2の上にボールボンディングした後ループ状に配線し、リードフレーム4で超音波接合が行われている。

【0004】一方最近の薄肉化を要求される配線においては前記ループ高さを低く抑える事、所謂低ループ配線が要求されている。これに対応する為、特開平1-293626号公報には第1ボンドと第2ボンドを逆にして配線すること、即ち最初にボールボンディングする位置をリードフレーム側にして行うことにより結果として低ループとするボンディング方法が提案されている。また特開平6-338532号公報には図1に示す配線において低ループとする為にボンディング線として所定組成の金合金線を用いる事が提案されている。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら特開平1-293626号公報に開示されている第1ボンドと第

2ボンドを逆にして配線する方法は、後からボンディングする超音波接合を確実にを行う為に配慮が必要となり生産性が悪くなってくる。また特開平6-338532号公報に開示されている様な組成の金合金線を用いた場合、ループ高さを低くする事が未だ不十分であるとともに高温状態に晒した後のボールボンディング部の接合強度が小さいという欠点を有している。

【0006】本発明は上述したような従来事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、半導体装置の薄肉化の要求に対応してループ高さを低くする事が出来ると共に、高温状態に晒した後のボールボンディング部の接合強度（以下高温接合強度という）に優れた半導体素子ボンディング用金合金線を提供することである。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明者等は鋭意研究を重ねた結果、所定量のPd、Pt、Agのうち少なくとも1種と所定量のBi及び残部が金と不可避不純物からなる組成の金合金線とすることにより、前述の目的を達成し得ることを知見し、本発明を完成するに至った。

【0008】こうして、本発明によれば下記が提供される。

（1）パラジウム（Pd）、白金（Pt）、銀（Ag）のうち少なくとも1種を0.2～20.0重量%、ビスマス（Bi）を0.0001～0.01重量%、及び残部が金と不可避不純物からなることを特徴とする半導体素子ボンディング用金合金線。

【0009】（2）パラジウム（Pd）、白金（Pt）、銀（Ag）のうち少なくとも1種が0.5～5.0重量%であることを特徴とする（1）記載の半導体素子ボンディング用金合金線。

（3）更にY、La、Ca、Euのうち少なくとも1種を0.1重量%以下含有することを特徴とする（1）、（2）記載の半導体素子ボンディング用金合金線。

【0010】（4）更にベリリウム（Be）を0.002重量%以下含有することを特徴とする（3）記載の半導体素子ボンディング用金合金線。

## 【0011】

【発明の実施の形態】原料金としては少なくとも99.99重量%以上に精製した高純度金を用いることが好ましい。更に好ましくは99.995重量%以上であり、最も好ましくは99.999重量%以上である。この為合金中の不純物は0.01重量%以下が好ましい。更に好ましくは0.005重量%以下であり、最も好ましくは0.001重量%以下である。

【0012】前記高純度金に所定量のBiとの共存において、Pd、Pt、Agのうち少なくとも1種を所定量含有した組成とする事によりループ高さを低くする事が出来ると共に、高温接合強度を向上させる事が出来る。Pd、Pt、Agのうち少なくとも1種の含有量が0.

2重量%未満になると、0.2重量%以上のものと対比してループ高さは高くなると共に高温接合強度は低くなる。Pd、Pt、Agのうち少なくとも1種の含有量が20.0重量%を超えると、ループ高さは高くなると共に高温接合強度は低くなる。この為Pd、Pt、Agのうち少なくとも1種の含有量は0.2~20.0重量%と定めた。

【0013】さらにPd、Pt、Agのうち少なくとも1種の含有量が0.5~5.0重量%の時、ループ高さは更に低くなり、高温接合強度は更に向上してくる。この為好ましくはPd、Pt、Agのうち少なくとも1種の含有量は0.5~5.0重量%である。高純度金に所定量のPd、Pt、Agのうち少なくとも1種との共存において、所定量のBiをさらに含有した組成とする事により、ループ高さを低くする事が出来ると共に、高温接合強度を向上させる事が出来る。

【0014】Biの含有量が0.0001重量%未満になると、0.0001重量%以上のものと対比してループ高さは高くなると共に高温接合強度は低くなる。Biの含有量が0.01重量%を超えると、ループ高さは高くなると共に高温接合強度は低くなる。この為Biの含有量は0.0001~0.01重量%と定めた。所定量のPd、Pt、Agのうち少なくとも1種とBiに加えて、Y、La、Ca、Euのうち少なくとも1種を0.1重量%以下をさらに含有した組成にすることにより、ループ高さを低くする事が出来ると共に、高温接合強度を向上させる効果を維持する事が出来る。

【0015】所定量のPd、Pt、Agのうち少なくとも1種と、Bi及び所定量のY、La、Ca、Euのうち少なくとも1種に加えて、Beを0.002重量%以下さらに含有した組成にすることにより、ループ高さを低くする事が出来ると共に、高温接合強度を向上させる効果を維持する事が出来る。本発明になる金合金線の好ましい製造方法を説明する。

【0016】高純度金に所定量の元素を添加し、真空溶解炉で溶解した後インゴットに铸造する。そのインゴットに溝ロール、伸線機を用いた冷間加工と中間アニールを施し、最終冷間加工により直径10~100μmの細

線とした後最終アニールを施す。本発明になる半導体素子ボンディング用金合金線は半導体装置の実装に際して、ICチップ等の半導体素子をリードフレームに配線して、樹脂やセラミックスで封止処理した半導体装置に用いられる。

【0017】

【実施例】表1~3に示す実施例及び比較例について説明する。

(実施例1) 純度99.999重量%の高純度金に所定量のPd及びBiを添加し真空溶解炉で溶解した後、铸造して表1に示す組成の金合金、即ち0.2重量% Pd、0.003重量% Bi、残部が金及び不可避不純物からなる組成のインゴットを得、これに溝ロール、伸線機を用いた冷間加工と中間アニールを施し、最終冷間加工により直径30μmとし、伸び率4%となるように最終アニールを行った。

【0018】この金合金線を全自動ワイヤボンダー(新川株式会社製 UTC-50型)を用いて、加熱温度200℃で、ICチップのAl電極とリードフレームを超音波併用熱圧着ボンディング法でピン数100個のボンディングした試料を作成した。この試料を測定顕微鏡(オリンパス株式会社製 STM-MJS型)を用いて、そのループ高さを測定した。ループ高さは図1に於いてICチップ1の上面を基準面として、ループの最も高い高さHを測定し、ループ高さとした。100個の測定を行い、その平均値をループ高さ平均値として表1に示した。

【0019】更に同様にしてピン数100個のボンディングした試料を作成し、200℃で500時間放置した後シアータスターを用いて剪断荷重を測定し、50箇所の平均値を高温接合強度として表1に示した。

(実施例2~41) および(比較例1~5) 金合金線の組成を表1~3に示すようにしたこと以外は実施例1と同様にして、直径30μmの線に仕上げ、ループ高さ平均値、高温接合強度を実施例1と同様にして測定し、その測定結果を表1~3に示した。

【0020】

【表1】

表 1

実施例	組 成 (重量%)										測 定 結 果	
	Pd	Pt	Ag	Bi	Y	La	Ca	Eu	Be	Au	ループの高さの平均値 ( $\mu\text{m}$ )	高温接合強度 (g)
1	0.2	—	—	0.003	—	—	—	—	—	残部	124	36
2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	58
3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	67
4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	52
5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	42
6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	128	35
7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	98	60
8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86	64
9	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	112	56
10	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	142	43
11	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	133	33
12	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	102	60
13	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	90	63
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	57
15	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	147	42
16	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85	61
17	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	92	63
18	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	95	59
19	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	60
20	—	—	—	0.0001	—	—	—	—	—	—	110	61
21	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	107	55
22	—	1.0	—	0.0001	—	—	—	—	—	—	98	62
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	56
24	—	—	1.0	0.0001	—	—	—	—	—	—	104	60
25	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	111	54

【0021】

【表2】

表 2

実施例	組 成 (重量%)										測 定 結 果	
	Pd	Pt	Ag	Bi	Y	La	Ca	Eu	Be	Au	ループの高さの平均値 ( $\mu\text{m}$ )	高温接合強度 (g)
26	1.0	—	—	0.003	0.0005	—	—	—	—	残部	86	64
27	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	88	68
28	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	84	66
29	0.2	—	—	0.003	0.005	—	—	—	—	—	129	35
30	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	67
31	20.0	—	—	0.003	0.005	—	—	—	—	—	144	42
32	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88	64
33	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	92	67
34	1.0	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	87	68
35	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	92	65
36	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	90	66
37	—	—	—	—	0.002	0.002	—	—	—	—	93	62
38	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	96	67
39	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	92	64
40	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	90	68
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	67

【0022】

【表3】

表 3

比較例	組 成 (重量%)										測 定 結 果	
	Pd	Pt	Ag	Bi	Y	Ca	Eu	Be	Pb	Au	ループの高さの平均値 ( $\mu\text{m}$ )	高温接合強度 (g)
1	—	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	残部	188	24
2	—	—	0.01	0.002	—	0.002	—	—	—	—	182	27
3	1.0	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	176	26
4	—	1.0	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	174	27
5	—	—	—	—	0.002	0.0025	—	0.0008	0.0008	—	195	21

【0023】 (試験結果)

t, Agのうち少なくとも1種を0.2~20.0重量

(1) 高純度金に、所定量のBiに加えて、Pd, P 50 %含有した組成である実施例1~19は、ループ高さが

84~147 $\mu$ mと低く、高温接合強度が33~67gと大きいものであった。

【0024】この中でもPd, Pt, Agのうち少なくとも1種を0.5~5.0重量%含有した組成では、ループ高さが84~113 $\mu$ mと更に低く、高温接合強度が52~67gと更に大きい為、好ましく用いられる。

(2)高純度金に、所定量のPd, Pt, Agのうち少なくとも1種を加えて、Biを0.0001~0.01重量%含有した組成である実施例20~25は、ループ高さが98~113 $\mu$ mと低く、高温接合強度が54~62gと大きいものであった。

【0025】(3)高純度金に、所定量のPd, Pt, Agのうち少なくとも1種と所定量のBiに加えて、Y, La, Ca, Euのうち少なくとも1種を0.0005~0.1重量%含有した組成である実施例26~39は、ループ高さ84~144 $\mu$ mと低く、高温接合強度が35~68gと大きいものであった。この中でもPd, Pt, Agのうち少なくとも1種を0.5~5.0重量%含有した組成では、ループ高さが84~110 $\mu$ mと更に低く、高温接合強度が62~68gと更に大きい為、好ましく用いられる。

【0026】(4)高純度金に、所定量のPd, Pt, Agのうち少なくとも1種と所定量のBiとY, La, Ca, Euのうち少なくとも1種に加えて、Beを0.0001~0.002重量%含有した組成である実施例40~41は、ループ高さが90~95 $\mu$ mと低く、高温接合強度が67~68gと大きいものであった。

(5)高純度金に、所定量のBi及びY, La, Ca, Euのうち少なくとも1種を含有するものの、本発明の必須成分であるPd, Pt, Agのうち少なくとも1種を含有しないか又は含有しても所定量に達しない比較例

1~2は、ループ高さが182~188 $\mu$ mと高く、高温接合強度が24~27gと低いものであった。

【0027】(6)高純度金に、所定量のPd, Pt, Agのうち少なくとも1種及びY, La, Ca, Euのうち少なくとも1種を含有するものの、本発明の必須成分であるBiを含有しない組成である比較例3~5は、ループ高さが174~195 $\mu$ mと高く、高温接合強度が21~27gと低いものであった。

【0028】

【発明の効果】本発明により0.2~20.0重量%のPd, Pt, Agのうち少なくとも1種及びBi 0.0001~0.01重量%のBiを含有し残部が金及び不可避不純物からなる組成を有する半導体素子ボンディング用金合金線によれば、ループ高さを低くする事が出来ると共に高温接合強度を向上させる事が出来る。

【0029】Pd, Pt, Agのうち少なくとも1種の含有量を0.5~5.0重量%にすることによりループ高さを低くする効果及び高温接合強度を向上させる効果が一段と向上してくる。前記含有成分に加えて所定量のY, La, Ca, Euのうち少なくとも1種又はそれに加えて所定量のBeを含有した組成においても、同様の効果を示すものである。

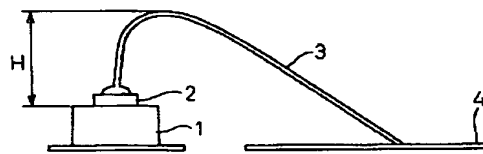
【図面の簡単な説明】

【図1】半導体素子のボンディングの様子を示す。

【符号の説明】

- 1…半導体素子
- 2…電極
- 3…金合金線
- 4…リードフレーム
- H…ループ高さ

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 藤本 祐介

東京都三鷹市下連雀八丁目5番1号 田中  
電子工業株式会社三鷹工場内

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**